

Триоды вакуумно-электронные. Оптоэлектронные
 устройства на однопереходном транзисторе
 типов Б96А, Б96Б. Частные технические условия.

Рис. 111111

П А С П О Р Т

оптоэлектронная пара на однопереходном
 транзистора типа **Б-96Б**

экспериментальные

Основные электрические параметры:

Наименование параметра	Услови. обознач.	Един. измер.	Номинальное значение	Примечание
Коэффициент передачи				
тип А	β		$0,5 \pm 0,7$	
тип Б			$0,65 \pm 0,85$	
межбазовое сопротивление	$R_{\text{бб}}$	ком	4 ± 9	
Ток утечки эмиттера перехода	$I_{\text{ут}}$	мкА	≤ 1	
Остаточное напряжение	$U_{\text{ост}}$	В	≤ 5	
Изменение коэфф. передачи	$\Delta\beta$	%	≥ 10	I

Примечание: $I = \frac{\beta_0 - \beta_1}{\beta_0} \cdot 100\%$

где β_0 — коэффициент передачи при $I_{\text{вх}} = 0$

β_1 — коэффициент передачи при $I_{\text{вх}} = 15 \text{ мА}$

Предельно-допустимые эксплуатационные режимы:

Наименование режима	Услови. обозн.	Един. измер.	Допустим. режим	Примечание
Максимально-допустим. мощность рассеивания	Р _{рас.}	мВт	400	I
Предельно-допустимое межбазов. напряжение	$U_{\text{бб, max}}$	В	30	
Средний ток эмиттера	$I_{\text{эср}}$	мА	50	
Амплитуда эмиттерного тока при $I_{\text{эср}} = 50 \text{ мА}$	$I_{\text{э, max}}$	А	I	
Амплитуда тока на входе	$I_{\text{вх, max}}$	мА	150	

ОТНМ

Примечание: I Допустимая мощность рассеивания в диапазоне тем-
 от 42°C до 70°C определяется по формуле $P_{\text{рас}} =$
 $\frac{P_{\text{рас}}(T_0 - 25)}{T_0 - 25}$, где $P_{\text{рас}}$ — макс. мощность при $T_0 = 25^{\circ}\text{C}$

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИБОРА

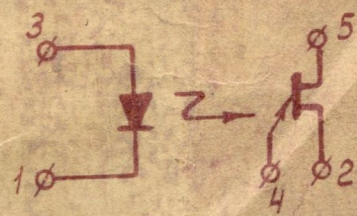
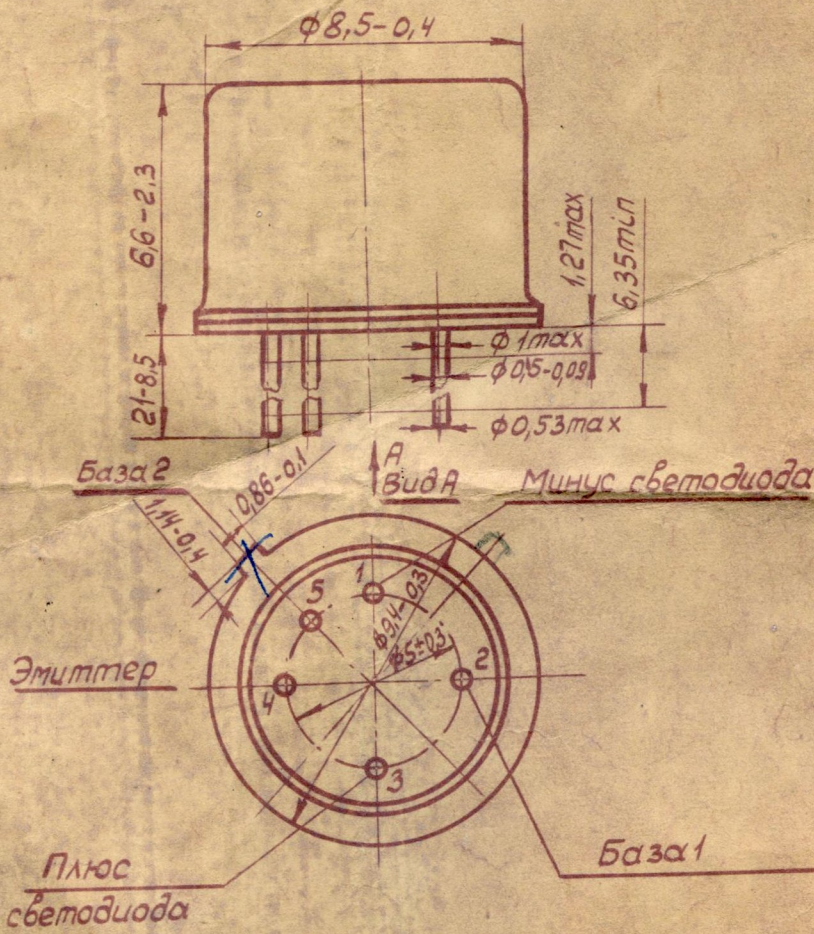


ТАБЛИЦА ЧЕРТЕЖ ПРИБОРА



ОТК 14

Кружков
Людмила